

JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 11283275 A

(43) Date of publication of application: 15.10.99

(51) Int. CI

G11B 7/24

G11B 7/24

G11B 7/24

G11B 7/24

G11B 7/24

(21) Application number: 11007459

(22) Date of filing: 14.01.99

(30) Priority:

27.01.98 JP 10 13661

(71) Applicant:

RICOH COLTD

(72) Inventor:

SHINOZUKA MICHIAKI YUZURIHARA HAJIME

DEGUCHI KOJI

TASHIRO HIROKO

(54) PHASE TRANSITION OPTICAL RECORDING MEDIUM

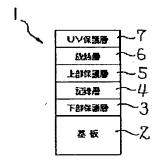
(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a phase transition optical recording medium having a structure or composition capable of phase difference tracking.

SOLUTION: A phase transition optical recording medium has the multilayer structure of successively laminating a lower protection layer 3, a recording layer 4, an upper protection layer 5, a radiating layer 6 and a UV protecting layer 7 on a transparent substrate 2. The optical phase difference of amolphous phases on the recording layer 4 between a recording mark and a crystal layer is more than 10°. The film thickness of the recording layer 4 is 0.027 to 0.033 times in comparison with the wavelength of laser light to be radiated. The film thickness of the lower protection layer 3 is 0.20 to 0.32 times in comparison with the said wavelength. The film thickness of the radiating layer 6 is 0.13 to 0.25 times in comparison with the said wavelength. The film thickness of the upper protection layer 5 is 0.025 to 0.038 times in comparison with the said wavelength. The recording layer 4 is made of Ag, In, Sb and Te at least. The reflection factor of the recording mark in

the amolphous phase of the recording layer 4 is higher than 50% of the reflectance of a crystal phase.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-283275

(43)公開日 平成11年(1999)10月15日

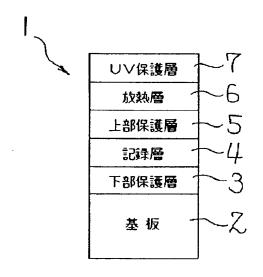
(51) Int.Cl. ⁶	識別記号		FΙ							
G11B 7/24	5 1 1		G 1	1 B	7/24		51	1		
	5 2 2						5 2 2	2 A		
	5 3 5						5 3	5 G		
	5 3 8						53	8 L		
	561						56	1 N		
		審査請求	未請求	請求	項の数12	OL	(全 8	頁)	最終頁	に続く
(21)出願番号	特願平11-7459		(71)	出願人	. 000006	747				
			ľ		株式会	社リコ				
(22)出顧日	平成11年(1999) 1月14日				東京都	大田区	中馬込]	L丁目	3番6号	
	•		(72)	発明者	篠塚	道明				
(31)優先権主張番号	特願平10-13661				東京都	大田区	中馬込	し丁目	3番6号	株式
(32)優先日	平10(1998) 1月27日	į			会社リ	コー内				
(33)優先権主張国	日本 (JP)		(72)	発明者	譲原	肇				
					東京都	大田区	中馬込	l 丁目	3番6号	株式
					会社リ	コー内				
			(72)	発明者	出口:	告司				
					東京都	大田区	中馬込 1	「工目	3番6号	株式
					会社リ	コー内				
			(74)	代理人	弁理士	柏木	慎史	外	1名)	
									最終頁	に続く
			l							

(54) 【発明の名称】 相変化型光記録媒体

(57)【要約】

【課題】 位相差トラッキングを可能とするような構造 や組成などを有する相変化型光記録媒体を提供する。

【解決手段】 相変化型光記録媒体 1 は、透明基板 2 の上に、下部保護層 3、記録層 4、上部保護層 5、放熱層 6、U V 保護層 7 を順次積層した多層構造である。記録層 4 のアモルファス相の記録マークと結晶層との光学的位相差は 1 0°以上である。記録層 4 の膜厚は、照射されるレーザ光の波長の 0.027~0.033倍である。下部保護層 3 の膜厚は、前記波長の 0.20~0.32倍である。放熱層 6 の膜厚は、前記波長の 0.13~0.25 倍である。上部保護層 5 の膜厚は、前記波長の 0.025~0.038倍である。記録層 4 は少なくとも A g , I n , S b , T e を材料としている。記録層 4 のアモルファス相の記録マークの反射率は、結晶相の反射率の 5 0%以上である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 いずれも少なくとも1層以上の記録層、 保護層および放熱層を透明基板上に形成した多層構造 で、前記記録層はアモルファス相と結晶相との間で可逆 的な相変化をすることにより情報の記録、消去を行なう 相変化型光記録媒体において、

ピット列のトラッキングに用いる位相差トラッキング信号の振幅が、少なくとも位相差トラッキングを可能とする大きさであることを特徴とする相変化型光記録媒体。

【請求項2】 前記アモルファス相の記録マークからの 反射光の位相を φ 1、前記結晶層からの反射光の位相を φ 2 としたときに、

 $\phi 1 - \phi 2 \ge 10^{\circ}$

であることを特徴とする請求項1に記載の相変化型光記 録媒体。

【請求項3】 記録層の膜厚が、照射されるレーザ光の 波長の0.023~0.033倍であることを特徴とす る請求項1または2に記載の相変化型光記録媒体。

【請求項4】 透明基板と記録層との間に保護層が形成されていて、この保護層の厚さが、照射されるレーザ光の波長の0.23~0.28倍であることを特徴とする請求項1~3のいずれかの一に記載の相変化型光記録媒体。

【請求項5】 放熱層の膜厚が、照射されるレーザ光の 波長の $0.13\sim0.25$ 倍であることを特徴とする請求項 $1\sim4$ のいずれかの一に記載の相変化型光記録媒体。

【請求項6】 記録層と放熱層との間に保護層が形成されていて、この保護層の厚さが、照射されるレーザ光の波長の0.026~0.036倍であることを特徴とする請求項1~5のいずれかの一に記載の相変化型光記録媒体。

【請求項7】 記録層の成分としてAg、In、SbおよびTeを含んでいることを特徴とする請求項1~6のいずれかの一に記載の相変化型光記録媒体。

【請求項8】 再生光によるアモルファス層の反射率が結晶層の反射率の50%以上であることを特徴とする請求項1~7のいずれかの一に記載の相変化型光記録媒体。

【請求項9】 透明基板の溝深さが40~60nmであることを特徴とする請求項1~8のいずれかの一に記載の相変化型光記録媒体。

【請求項10】 トラックピッチが0.6~0.8 μ m であることを特徴とする請求項1~9のいずれかの一に記載の相変化型光記録媒体。

【請求項11】 透明基板の溝幅が $0.25\sim0.40$ μ mであることを特徴とする請求項 $1\sim10$ のいずれかの一に記載の相変化型光記録媒体。

【請求項12】 情報の記録、再生の線速が3~8m/sであることを特徴とする請求項1~11のいずれかの

一に記載の相変化型光記録媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、記録層がアモルファス相と結晶相との間で可逆的な相変化をすることにより情報の記録、消去を行なう相変化型光記録媒体に関する。

[0002]

【従来の技術】再生のみが可能なDVD-ROMや、記録および再生が可能なDVD-Rに対して、記録、再生および消去が可能であるDVD-RAMが注目されている。また、光ディスクの再生装置で、トラッキングにる・カー信号を位相差トラッキングにより求める技術が知られている(特公昭56-30610号公報、特公平2-56734号公報など参照)。かかる技術は、凹凸の反射ピットのピット列からなる情報トラックを再生レーザー光スポットで走査して、反射光の光学的位相を変化し、反射光を受ける受光素子上での光強度の分布の変化をは出してピット列の中心からのずれを検出し、このずれ信号を最小とするように、再生レーザー光スポットの照射位置をサーボ制御してトラッキングするものである。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、相変化型光記録媒体で、DVD-ROMと同程度の記憶容量を備え、DVD-ROMドライブで再生可能なものは未だ知られていない。その理由のひとつとして、相変化型光記録媒体では、DVD-ROMと比べて、一般に物理信号特性としての反射率、振幅変調度が低く、信号強度が不足するため、DVD-ROMと同様にDVD-ROMドライブで再生することは困難であるという不具合があるためである。特に、ピット列トラッキングに用いられる位相差トラッキング信号(以下、"DPD信号"という)が充分に得られないため、トラッキング制御的は、どを有する相変化型光記録媒体を提供することにある。

[0004]

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明は、いずれも少なくとも1層以上の記録層、保護層および放熱層を透明基板上に形成した多層構造で、前記記録層はアモルファス相と結晶相との間で可逆的な相変化型をすることにより情報の記録、消去を行なう相変化型光記録媒体において、ピット列のトラッキングに用いる位相差トラッキング信号の振幅が、少なくとも位相をフッキングを可能とする大きさである。従って、ピット列のトラッキング信号の振幅が、少なくとも位相をトラッキングに用いる位相差トラッキング信号の振幅を大きくして、位相差トラッキングが可能な相変化型・大きくして、位相差トラッキングが可能な相変化型・大きくして、位相差トラッキングが可能な相変化型・表媒体を提供できる。請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の発明について、前記アモルファス相の記録マークからの反射光の位相をφ1、前記結晶層からの反射

光の位相をφ2としたときに、

 $\phi 1 - \phi 2 \ge 10^{\circ}$

である。従って、記録マークと結晶層との光学的位相差 を10°以上とすることで、位相差トラッキング信号の 振幅を大きくして、位相差トラッキングが可能な相変化 型光記録媒体を提供できる。請求項3に記載の発明は、 請求項1または2に記載の発明について、記録層の膜厚 が、照射されるレーザ光の波長の〇、〇23~〇、〇3 3倍である。従って、記録層の膜厚を、照射されるレー ザ光の波長の0.023~0.033倍とすることで、 位相差トラッキング信号の振幅を大きくして、位相差ト ラッキングが可能な相変化型光記録媒体を提供できる。 請求項4に記載の発明は、請求項1~3のいずれかの一 に記載の発明について、透明基板と記録層との間に保護 層が形成されていて、この保護層の厚さが、照射される レーザ光の波長の0. 23~0. 28倍である。従っ て、透明基板と記録層との間の保護層の厚さを、照射さ れるレーザ光の波長の0.23~0.28倍とすること で、位相差トラッキング信号の振幅を大きくして、位相 差トラッキングが可能な相変化型光記録媒体を提供でき る。請求項5に記載の発明は、請求項1~4のいずれか の一に記載の発明について、放熱層の膜厚が、照射され るレーザ光の波長の0.13~0.25倍である。従っ て、放熱層の膜厚を、照射されるレーザ光の波長の0. 13~0.25倍とすることで、位相差トラッキング信 号の振幅を大きくして、位相差トラッキングが可能な相 変化型光記録媒体を提供できる。請求項6に記載の発明 は、請求項1~5のいずれかの一に記載の発明につい て、記録層と放熱層との間に前記保護層が形成されてい て、この保護層の厚さが、照射されるレーザ光の波長の 0.026~0.036倍である。従って、記録層と放 熱層との間に形成する保護層の厚さを、照射されるレー ザ光の波長の0.026~0.036倍とすることで、 位相差トラッキング信号の振幅を大きくして、位相差ト ラッキングが可能な相変化型光記録媒体を提供できる。 請求項フに記載の発明は、請求項1~6のいずれかの一 に記載の発明について、記録層の成分としてAg、I n、SbおよびTeを含んでいる。従って、記録層の成 分としてAg、In、SbおよびTeを含んでいること により、位相差トラッキング信号の振幅を大きくして、 位相差トラッキングが可能な相変化型光記録媒体を提供 できる。請求項8に記載の発明は、請求項1~7のいず れかの一に記載の発明について、再生光によるアモルフ アス層の反射率が結晶層の反射率の50%以上である。 従って、再生光によるアモルファス層の反射率を結晶層 の反射率の50%以上として、位相差トラッキングが可 能な相変化型光記録媒体を提供できる。請求項9に記載 の発明は、請求項1~8のいずれかの一に記載の発明に ついて、透明基板の溝深さが40~60ヵmである。従 って、透明基板の溝深さを40~60nmとすることに

より、位相差トラッキング信号の振幅を大きくして、位 相差トラッキングが可能な相変化型光記録媒体を提供で きる。請求項10に記載の発明は、請求項1~9のいず れかの一に記載の発明について、トラックピッチが O. 6~0.8 µmである。従って、トラックピッチをO. 6~0.8 µmとすることにより、位相差トラッキング 信号の振幅を大きくして、位相差トラッキングが可能な 相変化型光記録媒体を提供できる。請求項11に記載の 発明は、請求項1~10のいずれかの一に記載の発明に ついて、透明基板の溝幅が 0. 25~0. 40 μ m であ る。従って、透明基板の溝幅を0.25~0.40μm とすることにより、位相差トラッキング信号の振幅を大 きくして、位相差トラッキングが可能な相変化型光記録 媒体を提供できる。請求項12に記載の発明は、請求項 1~11に記載の発明について、情報の記録、再生の線 速が3~8m/sである。従って、情報の記録、再生の 線速を3~8m/sとして、DVD-ROMプレーヤで 再生できる相変化型光記録媒体を提供できる。

[0005]

【発明の実施の形態】図1は、この発明の一実施の形態 にかかる相変化型光記録媒体1の層構造を示す断面図で ある。同図に示すように、この相変化型光記録媒体1 は、例えばポリカーボネート製の透明基板2の上に、下 部保護層3(例えばZnS. SiO2, SiNxなどの 相変化型材料を材料としている)、記録層 4 (例えばA) gInSbTe、GeSbTeなどを材料としてい る)、上部保護層5(例えばZnS. SiO2, SiN ×などを材料としている)、放熱層 6 (例えば A I , A I 合金、Au、Agなどを材料としている)、UV保護 層7 (例えばUV硬化型樹脂を材料としている) を順次 積層している。この発明は、このような層構成や材料に 限定されるものではないが、前記の層構成、材料とした 場合は、記録/再生およびオーバーライト特性が良くな るので好適である。なお、この相変化型光記録媒体1 は、円盤ディスク状にしてもよいし(相変化型光ディス ク)、カード状、シート状などにしてもよい。このよう な多層構造に形成された相変化型光記録媒体1は、位相 差トラッキングをしても、DVD-ROMと同等のDP D出力振幅が得られるようにして、DVD-ROMプレ ーヤで再生できるようにする等のため、その諸元を以下 のように設定する。

1. 光学的位相差を 10° 以上とする。図2は、相変化型光記録媒体1の光学的位相差($^\circ$) と、DPD出力振幅($=\Delta$ VTE[V]) との関係を示すグラフである。光学的位相差は、記録層4のアモルファス相の記録マークからの反射光の位相を ϕ 1、結晶層からの反射光の位相を ϕ 2としたときの、" ϕ 1 $-\phi$ 2"の値である。図2より、この光学的位相差が 10° 以上あれば、DPD出力振幅を0.3(V)以上にすることができることがわかる。これにより、位相差トラッキングをして10

D-ROMと同等の出力を得られるので、相変化型光記録媒体 1をDVD-ROMプレーヤで再生することができる。

2. 記録層4の膜厚が、照射されるレーザ光の波長入の O. 027~0. 033倍とする。相変化型光記録媒体 1の再生光であるレーザ光の波長を入(nm)としたと きに、記録層4の膜厚を変えて、DPD出力振幅

(V)、ジッタ (σ/Tw [%]) を測定したときの結 果が下記の表1である。この表は、再生レーザ光の波長 λ=635 (nm)、光ピックアップの対物レンズの開 口数NA=0.6、トラックの線密度=0.3 (μm/ bit)、信号フォーマットはEFM変調、として測定 したものである。また、この場合の相変化型光記録媒体 1のその他の具体的な構成は、記録層4はAgInSb Teを材料とし、下部保護層3はZnS. SiO2を材 料として膜厚を160nm、上部保護層5は2nS. S iO2を材料として膜厚を20nm、放熱層6はAI合 金を材料として膜厚120nm、とした。表1からは、 記録層4の膜厚をレーザ光の波長んの0.027~0. O33倍とすることで、ジッタもよく、DPD出力振幅 もO. 25 (V) 以上と大きくすることができることが わかる。これにより、位相差トラッキングをしてもDV D-ROMと同等の出力を得られるので、相変化型光記 録媒体1をDVD-ROMプレーヤで再生することがで きる。

[0006]

【表1】

記録層膜厚(nm)	DPD出力振幅(V)	ジッタ(a/Tw(%))
13(0,020× 1)	0, 20	10
17(0,027× A)	0. 25	7
21 (0, 033× X)	0.30	8
25(0,039× X)	0.31	10
33(0,052× ₹)	0.31	[]

3. 下部保護層3の膜厚が、照射されるレーザ光の波長 入の0.20~0.32倍とする。透明基板2と記録層 4との間に形成される下部保護層3の膜厚を変えて、D P D 出力振幅 (V)、ジッタ (σ/Tw [%]) を測定 したときの結果が下記の表2である。この表は、再生レ ーザ光の波長λ=635 (nm)、トラックの線密度= 3 (μm/b i t)、信号フォーマットはEFM変 調、として測定したものである。表2からは、下部保護 層3の膜厚をレーザ光の波長入の0.20~0.32倍 とすることで、ジッタもよく、DPD出力振幅も0.2 O(V)以上と大きくすることができることがわかる。 これにより、位相差トラッキングをしてもDVD-RO Mと同等の出力を得られるので、相変化型光記録媒体1 をDVD-ROMプレーヤで再生することができる。ま た、この場合の相変化型光記録媒体1のその他の具体的 な構成は、下部保護層3は2nS. SiO2を材料と し、記録層4はAgInSbTeを材料として膜厚を1 7 nm、上部保護層5はZnS. SiO2を材料として 膜厚を20mm、放熱層6はAI合金を材料として膜厚 120 nm、とした。

[0007]

【表2】

保護 層膜 厚 (nm)	DPD出力振幅(V)	ジッタ(o/Tw(%))
45 (0, 126× 2)	0, 25	10
85(0, 13× 1)	0.10	12
125(0,20× 1)	0, 20	8
165 (0.26× 2)	0.25	8
205(0.32×1)	0.21	9
245(0.39× 1)	0,12	23

nSbTeを材料として膜厚を17nm、上部保護層5はZnS、SiO2を材料として膜厚を20nm、とした。表3からは、放熱層6の膜厚をレーザ光の波長んの0.13~0.25倍とすることで、ジッタもよく、DPD出力振幅も0.25(V)以上と大きくすることができることがわかる。これにより、位相差トラッキングをしてもDVD-ROMと同等の出力を得られるので、相変化型光記録媒体1をDVD-ROMプレーヤで再生することができる。

[0008]

【表3】

	放熱層膜厚(nm)	DPD出力振幅(V)	ジッタ(o/Tw(X))
ı	48 (0.063× 1)	0, 25	12
1	80(0.13× λ)	0. 26	8
1	128(0, 19× X)	0.26	8
	160(0.25× 1)	0.25	8
1	200(0.31×1)	0, 26	10

5. 上部保護層5の膜厚は、照射されるレーザ光の波長 λのO. 025~O. 038倍とする。上部保護層5の 膜厚を変えて、DPD出力振幅(V)、ジッタ(σ \angle T w [%]) を測定したときの結果が下記の表4である。 この表は、再生レーザ光の波長λ=635 (nm)、ト ラックの線密度=O.3(μm/bit)、信号フォー マットはEFM変調、として測定したものである。ま た、この場合の相変化型光記録媒体1のその他の具体的 な構成は、上部保護層5は2nS. SiO2を材料と し、下部保護層3は2nS. SiO2を材料に膜厚を1 60nm、記録層4はAgInSbTeを材料として膜 厚を17nm、放熱層6はAI合金を材料とし膜厚を1 20nm、とした。表4からは、放熱層6の膜厚をレー ザ光の波長えの0.025~0.038倍とすること で、ジッタもよく、DPD出力振幅も0.25(V)以 上と大きくすることができることがわかる。これによ り、位相差トラッキングをしてもDVD-ROMと同等 の出力を得られるので、相変化型光記録媒体1をDVD ーROMプレーヤで再生することができる。

[0009]

【表4】

保護層膜厚(nm)	DPD出力振幅(V)	ジッタ(o/Tw(%))
12(0,019× l)	D , 22]
16 (0, 025× え)	0. 25	8
20 (0, 031× λ)	0, 26	8
24(0,038×ぇ)	0. 28	8
28 (0, 044× え)	0.29	10

6. 記録層 4 は少なくとも A g、 I n、 S b、 T e を材料として含む。記録層 4 の記録材料を変えて、D P D 出力振幅(V)、ジッタ(σ / T w [%])を測定したときの結果が下記の表 5 である。この表は、再生レーザ光の波長 λ = 6 3 5 (n m)、トラックの線密度 = 0.3(μ m / bit)、信号フォーマットはE F M 変調、として測定したものである。記録材料としては、A g - I n - S b - T e と、G e - S b T e とを用いて測定した。また、この場合の相変化型光記録媒体 1 のその他の具体的な構成は、記録層 4 の膜厚を 1 7 n m とし、上部

保護層 5 は 2 n S. Si O 2 を材料に膜厚を 2 O n m、下部保護層 3 は 2 n S. Si O 2 を材料に膜厚を 1 6 O n m、放熱層 6 は A I 合金を材料とし膜厚を 1 2 O n m、とした。表 5 からは、記録層 4 の材料に A g - I n - Sb - Te を用いることで、ジッタもよく、DPD出力振幅も 0. 2 5 (V) 以上と大きくすることができることがわかる。これにより、位相差トラッキングをしても D V D - R O M と同等の出力を得られるので、相変化型光記録媒体 1 を D V D - R O M プレーヤで再生することができる。これに対し、GeSbTe系材料では、線密度 0. 3 μ m λ bitでは、ジッタも 1 0%以上と悪く、DPD出力振幅も小さいので、位相差トラッキングができない。

【0010】なお、トラックの線密度を0.25 (μm/bit)以上としてもよい。この場合にはジッタが10%以下となる。

[0011]

【表5】

記録材料	DPD出力振幅(V)	ジッタ(a/Tw(%))
Ag-in-Sb-Te	0. 25	8
Ge-SbTe	0.18	12

7. 記録層4の記録マークであるアモルファス相の反射 率が、結晶相の反射率の50%以上である。記録層4で 結晶相の反射率Rcに対するアモルファス相の反射率R aの比(=Ra/Rc)を変えて、位相差トラッキング が可能か不可能かを試みた結果が下記の表6である。こ の表は、再生レーザ光の波長 $\lambda = 635$ (nm)、トラ ックの線密度= 0. 3 (μm/b i t)、信号フォーマ ットはEFM変調、として測定したものである。また、 この場合の相変化型光記録媒体1のその他の具体的な構 成は、上部保護層5は2nS. SiO2を材料に膜厚を 20nm、記録層4はAgInSbTeを材料に膜厚を 17 nm、下部保護層3は2nS. SiO2を材料に膜 厚を160nm、放熱層6はAI合金を材料とし膜厚を 120nm、とした。表6からは、Ra/Rcが50% 以上とすることで、位相差トラッキングが可能となるこ とがわかる。これにより、位相差トラッキングをしても DVD-ROMと同等の出力を得られるので、相変化型 光記録媒体1をDVD-ROMプレーヤで再生すること ができる。

[0012]

【表6】

反射率Ra(アモルファス)/反射率Rc(結晶)	位相差トラッキング
40×	不可能
50%	可能
60%	可能

8. 透明基板2の溝深さが40~60nmとする。透明基板2の溝深さを変えて、DPD出力振幅(V)、ジッ

 $g(\sigma/Tw[\%])$ を測定したときの結果が下記の表 7である。この表は、再生レーザ光の波長 $\lambda=635$ (nm)、トラックの線密度=0.3 (μ m/bit)、信号フォーマットはEFM変調、として測定したものである。また、この場合の相変化型光記録媒体1のその他の具体的な構成は、上部保護層5はZnS.SiO2を材料に膜厚を20nm、記録層4はAgInS.SiO2を材料に膜厚を17nm、下部保護層3はZnS.SiO2を材料に膜厚を160nm、放熱層6はAlS.SiO2を材料とし膜厚を160nm、とした。表7からは、透明基板2の溝深さが40~60nmとすることで、ジッタもよく、DPD出力振幅も0.25 (V)以上と大きくすることができることがわかる。これにより、位相差トラッキングをしてもDVD-ROMと同等の出力を得られるので、相変化型光記録媒体1をDVD-ROMとプレーヤで再生することができる。

[0013]

【表7】

満深さ(nm)	ジッタ(σ/Tw(%))	DPD出力振幅(V)
30	13	0, 13
40	В	0, 25
50	В	0.27
60	9	0.25
70	10	0, 22
80	12	0.19

9. トラックピッチを0. 6~0. 8 μmとする。相変 化型光記録媒体1のトラックピッチを変えて、DPD出 カ振幅(V)を測定したときの結果が下記の表8であ る。この表は、再生レーザ光の波長λ=635 (n m)、トラックの線密度=0.3(μm/bit)、信 号フォーマットはEFM変調、として測定したものであ る。また、この場合の相変化型光記録媒体1のその他の 具体的な構成は、上部保護層5はZnS. SiO2を材 料に膜厚を20nm、記録層4はAgInSbTeを材 料に膜厚を17nm、下部保護層3は2nS. SiO2 を材料に膜厚を160nm、放熱層6はAI合金を材料 とし膜厚を120nm、とした。表8からは、透明基板 2の溝深さが40~60nmとすることで、ジッタもよ く、DPD出力振幅も0. 25 (V) 以上と大きくする ことができることがわかる。これにより、位相差トラッ キングをしてもDVD-ROMと同等の出力を得られる ので、相変化型光記録媒体1をDVD-ROMプレーヤ で再生することができる。

【0014】 【表8】

トラックピッチ(µm)	DPD出力振幅(V)
0, 5	0.10
0,6	0.20
0.7	0.25
9, 8	0, 26
0.9	0.19

10. 透明基板2の溝幅を0. 25~0. 40μmとす る。相変化型光記録媒体1のトラックピッチを変えて、 DPD出力振幅(V)を測定したときの結果が下記の表 9 である。この表は、再生レーザ光の波長 λ = 635 (nm)、トラックの線密度=0.3 (μm/bi t)、信号フォーマットはEFM変調、として測定した ものである。また、この場合の相変化型光記録媒体1の その他の具体的な構成は、上部保護層5は2nS.Si O2を材料に膜厚を160nm、記録層4はAgInS b T e を材料に膜厚を17 nm、下部保護層3はZn S. SiO2を材料に膜厚を160nm、放熱層6はA 1合金を材料とし膜厚を120nm、とした。表9から は、透明基板2の溝幅を0.25~0.40μmとする ことで、ジッタもよく、DPD出力振幅も0.21 (V) 以上と大きくすることができることがわかる。こ れにより、位相差トラッキングをしてもDVD-ROM と同等の出力を得られるので、相変化型光記録媒体1を DVD-ROMプレーヤで再生することができる。

[0015]

【表9】

消韫(nm)	ジッタ(o/Tw(X))	DPD出力振幅(V)
0, 20	11	0.18
0, 25	9	0, 23
0.30	8	0, 25
0, 40	8	0,21
0. 45	10	0, 2
0, 50	11	0, 2

11. 情報の記録、再生の線速を3~8m/sとする。相変化型光記録媒体1の情報の記録、再生の線速を3~8m/sとすると、DVD-ROMの1~2倍速の場合の線速と同じであるため、相変化型光記録媒体1をDVD-ROMプレーヤで再生することができる。

【実施例】以下では、この発明の好適な一実施例について説明する。この実施例にかかる相変化型光記録媒体1の具体的な構成は次のようなものである。すなわち、透明基板2にはポリカーボネート(PC)を使用し、その屈折率を1.58とする。透明基板2上には下部保護層3をZnS.SiO2を材料に膜厚を160nmとして形成する。下部保護層3の上には記録層4をAg2In10Sb28Te60を材料に膜厚を17nmとして形成する。記録層4の上には上部保護層5をZnS.SiO2を材料に膜厚を20nm、屈折率2.1として形成する。上部保護層5の上には放熱層6をAl合金(Al

-Ti:1wt%)を材料に膜厚を120nmとして形成する。そして、上部保護層5の上には最上部層としてUV保護層7をUV硬化型樹脂を材料に形成する。このような相変化型光記録媒体1を用い、再生装置は、再生レーザ光の波長 λ を635(nm)、光ピックアップの対物レンズの開口数NAを0.6、トラックの線密度を0.3(μ m/bit)とする。さらに、オーバーライト時に照射するレーザ光のパワーは、図3に示すような4Tライトパルスの場合において、ピークパワーが12mW、ボトムパワーが5mW、リードパワーが1mWとなるマルチパルス発光波形によるものとする。

[0016]

【発明の効果】請求項1に記載の発明は、ピット列のトラッキングに用いる位相差トラッキング信号の振幅を大きくして、位相差トラッキングが可能な相変化型光記録媒体を提供できる。請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の発明について、記録マークと結晶層との光学的位相差を10°以上とすることで、位相差トラッキング信号の振幅を大きくして、位相差トラッキングが可能な相変化型光記録媒体を提供できる。

【0017】請求項3に記載の発明は、請求項1または 2に記載の発明について、記録層の膜厚を、照射される レーザ光の波長の0.023~0.033倍とすること で、位相差トラッキング信号の振幅を大きくして、位相 差トラッキングが可能な相変化型光記録媒体を提供でき る。請求項4に記載の発明は、請求項1~3のいずれか の一に記載の発明について、透明基板と記録層との間の 保護層の厚さを、照射されるレーザ光の波長の0.23 ~0. 28倍とすることで、位相差トラッキング信号の 振幅を大きくして、位相差トラッキングが可能な相変化 型光記録媒体を提供できる。請求項5に記載の発明は、 請求項1~4のいずれかの一に記載の発明について、放 熱層の膜厚を、照射されるレーザ光の波長の0. 13~ O. 25倍とすることで、位相差トラッキング信号の振 幅を大きくして、位相差トラッキングが可能な相変化型 光記録媒体を提供できる。請求項6に記載の発明は、請 求項1~5のいずれかの一に記載の発明について、記録 層と放熱層との間に形成する保護層の厚さを、照射され るレーザ光の波長の0.026~0.036倍とするこ とで、位相差トラッキング信号の振幅を大きくして、位 相差トラッキングが可能な相変化型光記録媒体を提供で きる。請求項7に記載の発明は、請求項1~6のいずれ

かの一に記載の発明について、記録層の成分としてA g、In、SbおよびTeを含んでいることにより、位 相差トラッキング信号の振幅を大きくして、位相差トラ ッキングが可能な相変化型光記録媒体を提供できる。請 求項8に記載の発明は、請求項1~7のいずれかの一に 記載の発明について、再生光によるアモルファス層の反 射率を結晶層の反射率の50%以上として、位相差トラ ッキングが可能な相変化型光記録媒体を提供できる。請 求項9に記載の発明は、請求項1~8のいずれかの一に 記載の発明について、透明基板の溝深さを40~60m mとすることにより、位相差トラッキング信号の振幅を 大きくして、位相差トラッキングが可能な相変化型光記 録媒体を提供できる。請求項10に記載の発明は、請求 項1~9のいずれかの一に記載の発明について、トラッ クピッチを0.6~0.8μmとすることにより、位相 差トラッキング信号の振幅を大きくして、位相差トラッ キングが可能な相変化型光記録媒体を提供できる。請求 項11に記載の発明は、請求項1~10のいずれかの一 に記載の発明について、透明基板の溝幅を0.25~ 0. 40μmとすることにより、位相差トラッキング信 号の振幅を大きくして、位相差トラッキングが可能な相 変化型光記録媒体を提供できる。請求項12に記載の発 明は、請求項1~11に記載の発明について、情報の記 録、再生の線速を3~8m/sとして、DVD-ROM プレーヤで再生できる相変化型光記録媒体を提供でき る。

【図面の簡単な説明】

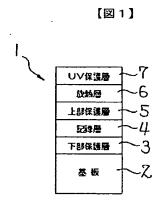
【図1】この発明の一実施の形態にかかる相変化型光記 録媒体の多層構造を示す断面図である。

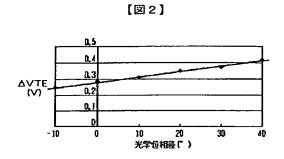
【図2】前記相変化型光記録媒体の光学的位相差とDP D出力振幅との関係を示すグラフである。

【図3】この発明の一実施例にかかる相変化型光記録媒体に照射するレーザ光のパワーを説明するためのパルス方式の波形を示すタイムチャートである。

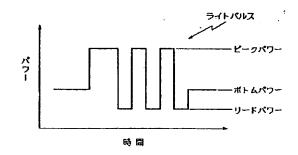
【符号の説明】

- 1 相変化型光記録媒体
- 2 透明基板
- 3 保護層
- 4 記録層
- 5 保護層
- 6 放熱層
- 7 UV保護層





【図3】



フロントページの続き

(51) Int. C1. 6

識別記号

G 1 1 B 7/24

561

FI

G 1 1 B 7/24

561P

(72)発明者 田代 浩子

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

会社リコー内

THIS PAGE BLANK (USPTO)